

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

К.т.н. В. М. Чміль

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Чл.-корр. НАНУ,

д.ф.м.н. А. Е. Беляев (г. Киев)

Д.т.н. Н. М. Вакив (г. Львов)

Д.т.н. В. Н. Годованюк (г. Черновцы)

К.т.н. А. А. Дашковский (г. Киев)

Д.т.н. Г. А. Оборский (г. Одесса)

Е. А. Тихонова (г. Одесса)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Д.т.н. С. Г. Антощук (г. Одесса)

Д.т.н. А. А. Ащеулов (г. Черновцы)

Д.т.н. В. В. Баранов (г. Минск)

Д.т.н. А. П. Бондарев (г. Львов)

К.т.н. Э. Н. Глушеченко (г. Киев),

зам. главного редактора

Д.ф.м.н. В. В. Должиков (г. Харьков)

К.т.н. И. Н. Еримичой (г. Одесса)

Д.т.н. А. А. Ефименко (г. Одесса),

зам. главного редактора

Д.ф.м.н. Д. В. Корбутяк (г. Киев)

Д.т.н. С. И. Круковский (г. Львов)

Д.т.н. С. Ю. Лузин (г. С.-Петербург)

Чл.-корр. НАНУ,

д.ф.м.н. В. С. Лысенко (г. Киев)

К.т.н. И. Л. Михеева (г. Киев)

Д.т.н. И. Ш. Невлюдов (г. Харьков)

Д.т.н. Ю. Е. Николаенко (г. Киев)

Д.ф.м.н. С. В. Пласкин (г. Днепр)

К.ф.м.н. А. В. Рыбка (г. Харьков)

К.т.н. В. В. Рюхтин (г. Черновцы)

Д.ф.м.н. М. И. Самойлович (г. Москва)

К.т.н. П. С. Сафронов (г. Одесса),

отв. секретарь редколлегии

Д.т.н. В. С. Ситников (г. Одесса)

Д.т.н. Я. Стеванович (г. Белград)

Д.т.н. З. Стевич (г. Белград)

Д.х.н. В. Н. Томашик (г. Киев)

К.т.н. В. Е. Трофимов (г. Одесса)

УЧРЕДИТЕЛИ

Институт физики полупроводников

им. В. Е. Лашкарева

Научно-производственное

предприятие «Сатурн»

Одесский национальный

политехнический университет

Издательство «Политехперіодика»

Одобрено к печати

Ученым советом ОНПУ

(Протокол № 8 от 29.06 2016 г.)

Отв. за выпуск: Е. А. Тихонова

СОДЕРЖАНИЕ

Новые компоненты для электронной аппаратуры

Омические контакты к материалам на основе нитрида индия. *П. О. Сай* (на английском языке)

3

Электронные средства: исследования, разработки

Экспериментальное исследование переходных процессов в программно-аппаратном устройстве цифровой фазовой автоподстройки частоты. *А. П. Бондарев, С. П. Алтунин*

15

Несущие конструкции с повышенными компоновочными характеристиками. *А. А. Ефименко, А. П. Карлангач*

23

Электрические и фотоэлектрические свойства гетероструктур $\text{NiO}/p\text{-CdTe}$ и $\text{NiO}/n\text{-CdTe}$. *Г. П. Пархоменко, П. Д. Марьянчук*

29

СВЧ-техника

Коммутационные управляемые устройства на $p-i-n$ диодах миллиметрового диапазона длин волн. *Н. Ф. Карушкин, В. В. Малышко, В. В. Ореховский, А. А. Тухаринов*

34

Системы передачи и обработки сигналов

Обнаружение аномальных измерений при обработке данных малого объема. *В. С. Попускайло*

42

Сенсоэлектроника

Исследование частотной зависимости проводимости нитевидных кристаллов кремния при криогенных температурах для создания сенсоров температуры на их основе. *А. А. Дружинин, П. П. Островский, Ю. Н. Ховерко, Р. Н. Корецкий*

47

Функциональная микро- и наноэлектроника

Координатно-чувствительный детектор заряженных частиц для спектроскопии. *В. П. Сидоренко, Ю. В. Прокофьев, Д. С. Мурченко, В. М. Еременко, А. В. Шелехов*

53

Обеспечение тепловых режимов

Модель взаимосвязи геометрии ветвей термоэлементов и показателей надежности однокаскадных охладителей в режиме $Q_{0\text{max}}$. *В. П. Зайков, В. М. Мещеряков, Ю. П. Журавлёв*

61

Список рецензентов номера

68

Новые книги

66